# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТА ЯНА–ТЕЛЛЕРА В ПРИМЕСНЫХ КРИСТАЛЛАХ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Н. С. Аверкиев<sup>a</sup>, И. Б. Берсукер<sup>b\*</sup>, В. В. Гудков<sup>c\*\*</sup>, И. В. Жевстовских<sup>c,d</sup>,

М. Н. Сарычев<sup>c</sup>, С. Жерлицын<sup> $e^*$ </sup>, С. Ясин<sup> $e^*$ </sup>, Ю. В. Коростелин<sup>f</sup>, В. Т. Суриков<sup>g</sup>

<sup>а</sup> Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 194021, Санкт-Петербург, Россия

<sup>b</sup> Institute for Theoretical Chemistry, University of Texas at Austin 78712, Austin, USA

> <sup>с</sup> Уральский федеральный университет 620002, Екатеринбург, Россия

<sup>d</sup> Институт физики металлов им. М. Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 620108, Екатеринбург, Россия

<sup>e</sup> Hochfeld-Magnetlabor Dresden (HLD-EMFL), Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf 01328, Dresden, Germany

<sup>f</sup> Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук 119991, Москва, Россия

<sup>9</sup> Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук 620990, Екатеринбург, Россия

> Поступила в редакцию 15 января 2019 г., после переработки 13 февраля 2019 г. Принята к публикации 15 февраля 2019 г.

Для кристаллов с примесными ионами в трехкратно вырожденном электронном T-состоянии разработан метод определения как симметрийных свойств деформаций, так и типа эффекта Яна – Теллера. Метод основан на расчетах изотермического вклада примесной подсистемы в упругие модули кристалла, поглощение и скорость нормальных мод для всех трех возможных задач:  $T \otimes e$ ,  $T \otimes t_2$  или  $T \otimes (e + t_2)$ . Проведено сравнение результатов расчета с экспериментальными данными. Эффективность метода продемонстрирована на примере кристалла  $CdSe: Cr^{2+}$ . Установлено, что центр  $CrSe_4$  описывается в рамках задачи  $T \otimes e$ . Определены параметры адиабатического потенциала основного состояния.

**DOI:** 10.1134/S0044451019070095

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

Исследование строения и свойств кристаллов с примесями 3*d*-элементов приобретает повышенное внимание в связи с их широким применением в квантовой оптике [1], электронике [2] и в качестве перспективных материалов для использования в квантовых компьютерах [3]. В связи с этим особой задачей является подробное описание основного и возбужденных состояний примесей. При малых концентрациях примесей можно считать, что они не взаимодействуют друг с другом, и учитывать лишь их взаимодействие с ближайшими соседями, рассматривая комплексы типа ML<sub>s</sub>, где М — металл, L — лиганд. Электронные термы в таких локальных образованиях в подавляющем большинстве случаев орбитально вырождены или псевдовырождены в основном или возбужденном состоянии, что в общем случае приводит к эффекту Яна – Теллера или к псевдоэффекту Яна – Теллера [4, 5]. Прямым след-

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> I. B. Bersuker, S. Zherlitsyn, S. Yasin

<sup>\*\*</sup> E-mail: gudkov@imp.uran.ru

ствием этих эффектов является спонтанное нарушение локальной симметрии с образованием адиабатического потенциала с несколькими эквивалентными минимумами, в которых система обладает пониженной симметрией, что приводит к целой серии специфических свойств [4,5].

Экспериментально эффект Яна-Теллера (ЭЯТ) преимущественно исследовался в допированных кристаллах, где примесные ионы обладают орбитально вырожденными электронными состояниями в тетраэдрическом (s = 4), октаэдрическом (s = 6) или кубическом (s = 8) окружении. При этом, как правило, используются оптические [6], магниторезонансные [7] и ультразвуковые [8] методы. Последние дают возможность напрямую (без применения модельных представлений) установить симметрийные свойства адиабатического потенциала основного состояния, получить значения констант вибронной связи и, с привлечением данных о силовых константах или энергиях ян-теллеровской (ЯТ) стабилизации, построить поверхность адиабатического потенциала комплекса.

Возможность определения симметрийных свойств глобальных минимумов адиабатического потенциала с помощью ультразвука связана с тем, что ультразвуковая волна, распространяясь в кристалле, создает деформации решетки определенной симметрии. Если эти деформации совпадают по симметрии с активными локальными колебательными модами ЯТ-центра, то возникает новый канал диссипации энергии, что приводит к дополнительному (примесному) вкладу в тензор модулей упругости. В эксперименте это проявляется в аномалиях температурных или магнитно-полевых зависимостей поглощения и скорости соответствующей ультразвуковой волны.

Ранее нами исследовались кубические кристаллы типа сфалерита [9] и флюорита [10]. В этих кристаллах ЯТ-ионы замещают ионы металлов и находятся, соответственно, в тетраэдрическом и кубическом окружении. Если представить, что тетраэдр формируется исключением из куба половины узлов, то в обоих случаях можно использовать единую терминологию в плане описания симметрийных свойств, а именно, тетрагональные (E), тригональные (T) и орторомбические (O) искажения. Последние являются комбинацией искажений Е-и Т-типов. В названных выше кубических кристаллах искажения ЯТ-комплексов совпадают по симметрии с искажениями решетки, поскольку главные оси комплексов параллельны главным осям кристалла. Поэтому наличие примесной добавки к компоненте тензо-



Рис. 1. (В цвете онлайн) Кристаллическая решетка типа вюрцита с примесью хрома, замещающей ион металла в тетраэдрическом окружении

ра упругих модулей  $(c_{11} - c_{12})/2$  свидетельствует о тетрагональной симметрии глобальных минимумов адиабатического потенциала [11], наличие добавки к модулю  $c_{44}$  указывает на тригональную симметрию минимумов [12], а наличие добавок в обоих модулях соответствует минимумам орторомбической симметрии [10].

Применение описанного выше метода в случае, когда главные оси ЯТ-комплекса не совпадают с главными осями кристалла, оказалось невозможным, поскольку нормальные объемные ультразвуковые моды, распространяясь в кристалле, в общем случае могут возбуждать несколько локальных вибронных мод, не давая определенного ответа относительно симметрийных свойств глобальных минимумов адиабатического потенциала. В таком случае необходимо вывести выражения для вкладов ЯТ-подсистемы в компоненты упругих модулей, провести соответствующие эксперименты и сравнить результаты расчетов с экспериментальными данными. В качестве примера, где проявляется такая ситуация, использовался кристалл селенида кадмия с примесями хрома. Этот кристалл имеет структуру вюрцита, ион  $Cr^{2+}$ , замещая ион  $Cd^{2+}$ , находится в тетраэдрическом окружении (рис. 1), и основное состояние центра является триплетом  ${}^{5}T_{2}(t_{2}^{2}e^{2})$ . Учет вибронного взаимодействия приводит к тому, что глобальные минимумы, в зависимости от соотношения между вибронными константами, могут быть тетрагональными (в задаче  $T\otimes e$ ЭЯТ) или тригональными (в задаче  $T \otimes t_2$ ), но могут быть и орторомбическими (в задаче  $T \otimes (e+t_2)$ ), если существенны квадратичные члены вибронного взаимодействия.

- -

Таблица І. Компоненты тензора модулеи упругости и своиства нормальных мод для кристалла типа вюрцита
$({f e}_i-{f e}_j$ иничный вектор в направлении распространения волны, ${f u}_i-{f e}_j$ ектор смещения создаваемого волной, $L$
и $S$ обозначают соответственно продольную и поперечную поляризации, «плюс» в правой колонке обозначает
пьезоактивную моду)

Модули	$\mathbf{e}_i$	$\mathbf{u}_i$	Поляризация	Пьезоэлектрические
упругости	U	U	(тип симметрии)	свойства
$c_{11}$	$[100], [10\overline{1}0]$	$[100], [10\overline{1}0]$	L	_
c <sub>33</sub>	[001], [0001]	[001], [0001]	L	+
$c_{44}$	[001], [0001]	$[100], [10\overline{1}0]$	S(T)	_
$c_{55}$	$[100], [10\overline{1}0]$	[001], [0001]	S(T)	+
c <sub>66</sub>	$[100], [10\overline{1}0]$	$[010], [\bar{1}2\bar{1}0]$	S(E)	_

Измерения температурных зависимостей поглощения и скорости нормальных мод, связанных с модулями  $c_{11}$ ,  $c_{33}$ ,  $c_{44}$ ,  $c_{55}$  и  $c_{66} = (c_{11} - c_{12})/2$ , выявили аномалии релаксационного типа для всех мод за исключением  $c_{33}$ . Основываясь на способе интерпретации экспериментальных данных, применявшемся для кубических кристаллов, можно было бы утверждать, что в данном случае глобальные минимумы имеют орторомбическую симметрию, однако тогда и в модуле  $c_{33}$  следовало бы наблюдать аномалии, аналогичные обнаруженным в других модулях.

Релаксационные процессы возникают, когда энергетические уровни по-разному смещаются под воздействием ультразвуковой волны, приводя к неравновесному состоянию системы. Чтобы понять, в каком случае волна, создающая относительные деформации типа  $\varepsilon_3$ , оставляет систему в равновесном состоянии (без аномалии в модуле  $c_{33}$ ), нами были рассмотрены смещения энергетических уровней под действием деформаций для случаев линейных  $(T \otimes e, T \otimes t_2)$ , и квадратичной  $(T \otimes (e + t_2))$  задач ЭЯТ. Было установлено, что в случае задачи  $T\otimes e$ под действием деформаций типа  $\varepsilon_3$  уровни энергии смещаются синхронно, не создавая неравновесности в системе, в то время как для других случаев деформации типа  $\varepsilon_3$  снимают вырождение, что привело бы к аномалиям релаксационного типа для модуля сзз.

#### 2. ЭКСПЕРИМЕНТ

Образец CdSe: Cr<sup>2+</sup> был выращен в Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН газотранспортным методом [13]. Он имел структуру  $\alpha$ -CdSe (гексагональная, класс 6mm,  $P6_3mc$ ,  $C_{6v}^4$  [14]). Концентрация примесей была определена в Институте химии твердого тела УрО РАН с использованием метода индуктивно-связанной плазмы на массспектрометре ELAN 9000 (Perkin-Elmer SCIEX). Концентрация примесей хрома составила  $n_{\rm Cr} =$  $= (1.41\pm0.07)\cdot10^{18}$  см<sup>-3</sup> и существенно превосходила концентрации других 3*d*-элементов (Co, Cu, Mn, Ni, Ti, V).

Измерения поглощения и фазовой скорости ультразвуковых волн были выполнены в Уральском федеральном университете и в Лаборатории сильных магнитных полей (Дрезден) с помощью установок, работающих по принципу перестраиваемого по частоте высокочастотного моста [15, 16]. Волны генерировались и регистрировались пьезопреобразователями из ниобата лития в частотном диапазоне 28-105 МГц. В табл. 1 приведены исследованные компоненты тензора упругих модулей и соответствующие нормальные моды: i = 1 - продольнаямода, распространяющаяся вдоль оси x; i = 2 продольная мода, распространяющаяся вдоль оси z; *i* = 3 — поперечная мода, распространяющаяся вдоль оси z и поляризованная вдоль оси x; i = 4 - 4поперечная мода, распространяющаяся вдоль ос<br/>и $\boldsymbol{x}$ и поляризованная вдоль оси z; i = 5 — поперечная мода, распространяющаяся вдоль оси x и поляризованная вдоль оси у.

Если переменные, связанные с ультразвуковой волной, определены как пропорциональные  $\exp[i(\omega t - \mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r})]$  и комплексный волновой вектор  $\mathbf{k}_i = (\omega/v_i - i\alpha_i)\mathbf{e}_i$  (где  $\omega$  — круговая частота волны,  $\mathbf{e}_i = \mathbf{k}_i/|\mathbf{k}_i|$ ), то изменения фазовой скорости  $v_i$ и коэффициента поглощения  $\alpha_i$  нормальных мод



Рис. 2. Температурные зависимости действительной (кривая 1) и мнимой (2) составляющих динамических модулей упругости  $c_{44}$  (a) и  $c_{33}$  (b) в кристалле  $CdSe: Cr^{2+}$ ;  $\Delta c_{ii}/c_{ii} = [c_{ii}(T) - c_{ii}(T_0)]/c_{ii}(T_0)$ ,  $T_0 = 3.7$  K (a) и  $T_0 = 3.8$  K (b), частота  $\omega/2\pi = 55$  МГц



**Рис. 3.** (В цвете онлайн) Искажения комплекса  $\operatorname{CrSe}_4$  по координатам  $Q_\vartheta$  (*a*),  $\frac{1}{\sqrt{3}}(Q_\xi + Q_\eta + Q_\zeta)$  (*б*) и положение комплекса в декартовой системе координат, связанной с кристаллической решеткой (*b*)

связаны с изменениями действительной и мнимой компонент упругих модулей, приведенных в табл. 1, следующим образом:

$$\operatorname{Re}\frac{\Delta c_{ii}(T)}{c_{ii}(T_0)} = -2\operatorname{Re}\frac{k_i(T)}{k_i(T_0)} = 2\frac{\Delta v_i(T)}{v_i(T_0)},\qquad(1)$$

$$\operatorname{Im} \frac{\Delta c_{ii}(T)}{c_{ii}(T_0)} = -2 \frac{\operatorname{Im} k_i(T)}{\operatorname{Re} k_i(T_0)} = 2 \frac{\Delta \alpha_i(T)}{\operatorname{Re} k_i(T_0)}, \quad (2)$$

где  $T_0$  — температура, относительно которой определяются изменения величин, например,  $\Delta c_{ii} = c_{ii}(T) - c_{ii}(T_0)$ . Именно эти частотно-зависимые модули измеряются в эксперименте. Далее мы будем называть их динамическими. Вывод соотношений (1), (2) приведен в [17]. Он основан на решении волнового уравнения, записанном в виде  $c_{ii} = \rho v_i^2$ ( $\rho$  — плотность вещества), предположении о малом изменении величин  $c_{ii}(T)$ ,  $k_i(T)$  и  $v_i(T)$  относительно значений при  $T = T_0$  и аналитическом продолжении  $c_{ii}$  в комплексную плоскость.

Релаксационный вклад в динамические упругие модули, обусловленный ЯТ-подсистемой, может быть записан как [18]

$$\frac{\Delta c_{ii}}{c_{ii}(T_0)} = \frac{(c_{JT}^T)_{ii}}{c_{ii}(T_0)} \frac{1 - i\omega\tau}{1 + (\omega\tau)^2},\tag{3}$$

где  $(c_{JT}^T)_{ii}$  — изотермический вклад ЯТ-подсистемы в полный динамический модуль упругости  $c_{ii}$ ,  $\tau$  — время релаксации искажений ЯТ-комплексов. Функция  $1/[1+(\omega\tau)^2]$  представляет собой размытую ступеньку, локализованную в точке, соответствующей  $\omega\tau = 1$ , в то время как  $\omega\tau/[1+(\omega\tau)^2]$  имеет вид пика, расположенного в этой же точке. Изо-

Таблица 2. Положения тетрагональных минимумов в координатах  $(Q_{\vartheta}, Q_{\varepsilon})$ 

$\mathbf{Q}_1^E$	$\mathbf{Q}_2^E$	$\mathbf{Q}_2^E$
$Q_0^E(1,0)$	$Q_0^E\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$	$Q_0^E\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

термический модуль  $(c_{JT}^T)_{ii} \propto 1/T$  (см., например, [8]), в результате чего характерные аномалии, обусловленные релаксационным вкладом, имеют вид, приведенный на рис. 2. Температурные зависимости действительной и мнимой составляющих модуля  $c_{33}$ , показанные на рис. 3, тоже являются характерными [19], но для модулей, не содержащих релаксационного вклада.

#### 3. РЕЛАКСАЦИЯ ЯТ-ИСКАЖЕНИЙ

Для описания процесса релаксации запишем выражения для энергии ЯТ-комплексов, зависящей от симметризованных координат, в минимумах адиабатического потенциала.

В случае задачи  $T \otimes e$  ЭЯТ имеются три листа адиабатического потенциала (см. стр. 64 в [4]):

$$E_1^{\nu} = F_E Q_{\vartheta},$$

$$E_2^{\nu} = F_E \left(\frac{1}{2}Q_{\vartheta} + \frac{\sqrt{3}}{2}Q_{\varepsilon}\right),$$

$$E_3^{\nu} = F_E \left(\frac{1}{2}Q_{\vartheta} - \frac{\sqrt{3}}{2}Q_{\varepsilon}\right),$$
(4)

с минимумами в точках  $Q_0^E = F_E/K_E$  (табл. 2), где F<sub>E</sub> — тетрагональная линейная константа вибронной связи,  $K_E$  — первичная (без учета ЭЯТ) силовая константа, относящаяся к тетрагональным искажениям. На рис. За и 4 видно, что симметризованная координата  $Q_{\vartheta}$  описывает искажения куба вдоль одного из ребер. В общем случае выражение для энергии в трех минимумах адиабатического потенциала (n = 1, 2, 3) с учетом внешних тетрагональных деформаций, выраженных через изменения ребер  $\Delta b_n$ , и в пренебрежении квадратичными поправками можно записать в виде

$$E_{n} = \frac{1}{2}K_{E}Q_{n}^{2} = \frac{1}{2}K_{E}(Q_{0}^{E} + \Delta b_{n})^{2} =$$
$$= \frac{F_{E}^{2}}{2K_{E}} + F_{E}\Delta b_{n} + O(\Delta b_{n}^{2}) \approx \frac{F_{E}^{2}}{2K_{E}} + F_{E}\Delta b_{n}.$$
 (5)



Рис. 4. (В цвете онлайн) Тетрагональные искажения комплекса по симметрийной координате  $Q_{\vartheta}$ , представленные в проекциях на плоскости, заданные в декартовой системе координат, связанной кубом: а — на плоскость ([110], [001]); б — ([001], [110]); в — ([110], [110]). Штриховыми линиями показана искаженная конфигурация куба

Таким образом, изменения энергии, вызванные ультразвуковой волной, создающей деформации типа  $\varepsilon_i$ , имеют вид

$$\Delta E_n(\varepsilon_i) = F_E \Delta b_n(\varepsilon_i). \tag{6}$$

На рис. Зв видно, что для этого случая следует учесть изменения ребер 2-5, 2-7 и 2-8. Нормальные моды, распространяющиеся в направлении гексагональной оси z, создают деформации типа

$$\varepsilon_3 = \frac{\partial u_z}{\partial z}, \quad \varepsilon_4 = \frac{\partial u_y}{\partial z},$$

а распространяющиеся в базисной плоскости вдоль оси x —

$$\varepsilon_1 = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \varepsilon_5 = \frac{\partial u_z}{\partial x}, \quad \varepsilon_6 = \frac{\partial u_y}{\partial x}$$

В табл. 3 приведены выражения для изменений длин ребер куба при различных деформациях  $\varepsilon_i$ .

Рассмотрим задачу  $T \otimes t_2$  ЭЯТ. В данном случае адиабатический потенциал задается в трех тригональных симметрийных координатах:  $Q_{\xi}, Q_{\eta}$  и  $Q_{\zeta}$ (см. стр. 65 в [4]) и представляется в виде четырех листов с минимумами в точках  $Q_0^T = 2F_T/3K_T$ 

	$\Delta b_1 =  \mathbf{r}_5 - \mathbf{r}_2 $	$\Delta b_2 =  \mathbf{r}_7 - \mathbf{r}_2 $	$\Delta b_3 =  \mathbf{r}_8 - \mathbf{r}_2 $
$\varepsilon_1$	$a\frac{\sqrt{2}}{3}\varepsilon_1$	$\frac{a}{6\sqrt{2}}\varepsilon_1$	$\frac{a}{6\sqrt{2}}\varepsilon_1$
$\varepsilon_3$	$\frac{a}{3\sqrt{2}} \varepsilon_3$	$\frac{a}{3\sqrt{2}}\varepsilon_3$	$\frac{a}{3\sqrt{2}}\varepsilon_3$
$\varepsilon_4$	$O(\varepsilon_4^2)$	$-\frac{a}{2\sqrt{3}}\varepsilon_4$	$\frac{a}{2\sqrt{3}}\varepsilon_4$
$\varepsilon_5$	$-rac{a}{3}arepsilon_5$	$\frac{a}{6} \varepsilon_5$	$\frac{a}{6} \varepsilon_5$
$\varepsilon_6$	$O(\varepsilon_6^2)$	$-\frac{a}{2\sqrt{6}}\varepsilon_6$	$\frac{a}{2\sqrt{6}}\varepsilon_6$

**Таблица 3.** Изменение длин ребер куба при деформациях  $\varepsilon_i$  (a = 4.3 Å — параметр решетки)

**Таблица 4.** Положения тригональных минимумов в координатах  $(Q_{\xi}, Q_{\eta}, Q_{\zeta})$ 

$\mathbf{Q}_1^T$	$\mathbf{Q}_2^T$	$\mathbf{Q}_3^T$	$\mathbf{Q}_4^T$
$Q_0^T(1, 1, 1)$	$Q_0^T(-1, 1, -1)$	$Q_0^T(1, -1, -1)$	$Q_0^T(-1, -1, 1)$



Рис. 5. (В цвете онлайн) Тригональные искажения комплекса по симметризованной координате  $(Q_{\xi} + Q_{\eta} + Q_{\zeta})/\sqrt{3}$ , представленные в проекциях на плоскости, заданные в декартовой системе координат, связанной кубом: a — на плоскость ([110], [001]);  $\delta$  — ([001], [1 $\overline{1}$ 0]);  $\epsilon$  — ([110], [1 $\overline{1}$ 0]). Штриховыми линиями показана искаженная конфигурация куба

(табл. 4), где  $F_T$  — тригональная линейная константа вибронной связи,  $K_T$  — первичная силовая константа без учета ЭЯТ, относящаяся к тригональным искажениям. На рис. 36 и рис. 5 видно, что симметризованная координата  $(Q_{\xi} + Q_{\eta} + Q_{\zeta})/\sqrt{3}$  описывает искажения куба вдоль одной из пространственных диагоналей. В общем случае выражение для энергии в четырех минимумах адиабатического потенциала (m = 1, 2, 3, 4) с учетом внешних тригональных деформаций, выраженных через изменения длин пространственных диагоналей куба,  $\Delta d_m$ , можно записать следующим образом:

$$E_m = \frac{1}{2} K_T \left( \sqrt{3} Q_0^T + \Delta d_m \right)^2 = K_T \left[ \frac{3}{2} (Q_0^T)^2 + \sqrt{3} Q_0^T \Delta d_m + O(\Delta d_m^2) \right] \approx \frac{2F_T^2}{3K_T} + \frac{2}{\sqrt{3}} F_T \Delta d_m.$$
(7)

Таким образом, изменение энергии, обусловленное деформациями  $\varepsilon_i$ , создаваемыми ультразвуковыми волнами, можно выразить через изменения длин пространственных диагоналей,  $\Delta d_m$ , приведенных в табл. 5:

$$\Delta E_m = \frac{2}{\sqrt{3}} F_T \Delta d_m. \tag{8}$$

Энергия ЯТ-стабилизации в случае орторомбических минимумов имеет вид [4]

$$E_{JT}^{O} = \frac{1}{4}E_{JT}^{E} + \frac{3}{4}E_{JT}^{T}.$$
(9)

Изменения энергий в минимумах адиабатического потенциала, вызванные упругими деформациями, запишутся в аналогичной форме (k = 1, 2, 3, 4, 5, 6):

$$(\Delta E_{JT}^{O})_{k} = \frac{1}{4} (\Delta E_{JT}^{E})_{k} + \frac{3}{4} (\Delta E_{JT}^{T})_{k}.$$
 (10)

С учетом координат орторомбических минимумов, приведенных в табл. 6, и координат тетрагональных и тригональных минимумов (см. табл. 2 и 4) уравнения для изменений энергии, аналогичные формулам (6) и (8), но для случая орторомбических глобальных минимумов, можно записать в виде

	$\Delta d_1 =  \mathbf{r}_5 - \mathbf{r}_4 $	$\Delta d_2 =  \mathbf{r}_6 - \mathbf{r}_2 $	$\Delta d_3 =  \mathbf{r}_8 - \mathbf{r}_3 $	$\Delta d_4 =  \mathbf{r}_7 - \mathbf{r}_1 $
$\varepsilon_1$	0	$\sqrt{\frac{2}{3}} \frac{4a}{3} \varepsilon_1$	$\sqrt{rac{2}{3}}  rac{a}{3}  arepsilon_1$	$\sqrt{rac{2}{3}}  rac{a}{3}  arepsilon_1$
$arepsilon_3$	$\sqrt{\frac{3}{2}} a \varepsilon_3$	$\sqrt{rac{3}{2}}  rac{a}{9}  arepsilon_3$	$\sqrt{\frac{3}{2}} \frac{a}{9} \varepsilon_3$	$\sqrt{rac{3}{2}}  rac{a}{9}  arepsilon_3$
$\varepsilon_4$	0	$O(\varepsilon_4^2)$	$rac{a}{3}arepsilon_4$	$-rac{a}{3}arepsilon_4$
$\varepsilon_5$	0	$\frac{2a}{3\sqrt{3}}\varepsilon_5$	$-rac{a}{3\sqrt{3}}arepsilon_5$	$-rac{a}{3\sqrt{3}}arepsilon_5$
$\varepsilon_6$	0	$O(arepsilon_6^2)$	$-a\frac{\sqrt{2}}{3}\varepsilon_6$	$a\frac{\sqrt{2}}{3}\varepsilon_6$

Таблица 5. Изменение длин пространственных диагоналей куба при деформациях  $\varepsilon_i$ 

**Таблица 6.** Положения орторомбических минимумов в координатах  $(Q_{\vartheta}, Q_{\varepsilon}, Q_{\xi}, Q_{\eta}, Q_{\zeta})$ 

$\mathbf{Q}_1^O$	$\mathbf{Q}_2^O$	$\mathbf{Q}_3^O$	$\mathbf{Q}_4^O$	$\mathbf{Q}_5^O$	$\mathbf{Q}_6^O$
$-\frac{1}{2}\mathbf{Q}_1^E + \\ +\frac{3}{4}(\mathbf{Q}_1^T + \mathbf{Q}_2^T)$	$ \begin{vmatrix} -\frac{1}{2}  \mathbf{Q}_1^E + \\ +\frac{3}{4} (\mathbf{Q}_3^T + \mathbf{Q}_4^T) \end{vmatrix} $	$-\frac{1}{2} \mathbf{Q}_2^E + \\ +\frac{3}{4} (\mathbf{Q}_1^T + \mathbf{Q}_3^T)$	$-\frac{1}{2}\mathbf{Q}_2^E + \\ +\frac{3}{4}(\mathbf{Q}_2^T + \mathbf{Q}_4^T)$	$-\frac{1}{2} \mathbf{Q}_3^E + \\ +\frac{3}{4} (\mathbf{Q}_1^T + \mathbf{Q}_4^T)$	$-\frac{1}{2}\mathbf{Q}_3^E + \\ +\frac{3}{4}(\mathbf{Q}_2^T + \mathbf{Q}_3^T)$

$$\begin{split} (\Delta E_{JT}^{O})_{1} &= \frac{1}{4} (-F_{E} \Delta b_{1}) + \\ &+ \frac{3}{4} \left[ \frac{2}{\sqrt{3}} F_{T} (\Delta d_{1} + \Delta d_{2}) \right], \\ (\Delta E_{JT}^{O})_{2} &= \frac{1}{4} (-F_{E} \Delta b_{1}) + \\ &+ \frac{3}{4} \left[ \frac{2}{\sqrt{3}} F_{T} (\Delta d_{3} + \Delta d_{4}) \right], \\ (\Delta E_{JT}^{O})_{3} &= \frac{1}{4} (-F_{E} \Delta b_{2}) + \\ &+ \frac{3}{4} \left[ \frac{2}{\sqrt{3}} F_{T} (\Delta d_{1} + \Delta d_{3}) \right], \\ (\Delta E_{JT}^{O})_{4} &= \frac{1}{4} (-F_{E} \Delta b_{2}) + \\ &+ \frac{3}{4} \left[ \frac{2}{\sqrt{3}} F_{T} (\Delta d_{2} + \Delta d_{4}) \right], \\ (\Delta E_{JT}^{O})_{5} &= \frac{1}{4} (-F_{E} \Delta b_{3}) + \\ &+ \frac{3}{4} \left[ \frac{2}{\sqrt{3}} F_{T} (\Delta d_{1} + \Delta d_{4}) \right], \\ (\Delta E_{JT}^{O})_{6} &= \frac{1}{4} (-F_{E} \Delta b_{3}) + \\ &+ \frac{3}{4} \left[ \frac{2}{\sqrt{3}} F_{T} (\Delta d_{2} + \Delta d_{4}) \right]. \end{split}$$

Подставляя в уравнения (11) выражения для  $\Delta b_n$  и  $\Delta d_m$ , приведенные в табл. 3 и 5, получим представленные в табл. 7 выражения для изменений энергии в минимумах адиабатического потенциала, вызванных упругими деформациями.

Используя выражения для изменений энергии, обусловленных деформациями при различных типах задач ЭЯТ (задача  $T \otimes e$ , уравнение (6) и табл. 3; задача  $T \otimes t_2$ , уравнение (8), табл. 5; квадратичная задача  $T \otimes (e + t_2)$ , уравнения (11) и табл. 7), можно записать следующие выражения для статистических сумм:

$$Z = \sum_{k} \exp\left(-\frac{\Delta E_k}{k_B T}\right),\tag{12}$$

которые дают возможность вычислить изотермический вклад ЯТ-подсистемы (см., например, стр. 136 в [8]):

$$(c_{JT}^{T})_{ii} = -n_{\rm Cr} k_B T \left(\frac{\partial^2}{\partial \varepsilon_i^2} \ln Z\right)_{\varepsilon_i = 0}.$$
 (13)

Затем можно определить динамические упругие модули кристалла (уравнение (3)), поглощение (уравнение (2)) и дисперсию (уравнение (1)) объемных нормальных мод. Результат дифференцирования приведен в табл. 8.

	$\Delta E_1^O$	$\Delta E_2^O$	$\Delta E_3^O$	$\Delta E_4^O$	$\Delta E_5^O$	$\Delta E_6^O$
C.	$\left(-\frac{F_E}{6\sqrt{2}}\right. +$	$\left(-\frac{F_E}{6\sqrt{2}}\right. +$	$\left(-\frac{F_E}{24\sqrt{2}}\right. +$	$\left(-\frac{F_E}{24\sqrt{2}}\right. +$	$\left(-\frac{F_E}{24\sqrt{2}}\right. + $	$\left(-\frac{F_E}{24\sqrt{2}}\right. + $
٤1	$+\frac{4F_T}{3\sqrt{2}}\right)a\varepsilon_1$	$+\frac{2F_T}{3\sqrt{2}}\right)a\varepsilon_1$	$+\frac{F_T}{3\sqrt{2}}\right)a\varepsilon_1$	$+\frac{5F_T}{3\sqrt{2}}\right)a\varepsilon_1$	$+ \frac{F_T}{3\sqrt{2}} \bigg) a\varepsilon_1$	$+\frac{5F_T}{3\sqrt{2}}\right)a\varepsilon_1$
	$\left(-\frac{F_E}{12\sqrt{2}}\right. +$	$\left(-\frac{F_E}{12\sqrt{2}}\right. +$	$\left(-\frac{F_E}{12\sqrt{2}}\right. +$	$\left(-\frac{F_E}{12\sqrt{2}}\right. +$	$\left(-\frac{F_E}{12\sqrt{2}}\right. +$	$\left(-\frac{F_E}{12\sqrt{2}}\right. +$
83	$+\frac{5F_T}{3\sqrt{2}}\right)aarepsilon_3$	$+ \frac{F_T}{3\sqrt{2}} \bigg) a\varepsilon_3$	$+\frac{5F_T}{3\sqrt{2}}\right)aarepsilon_3$	$+ \frac{F_T}{3\sqrt{2}} \bigg) a\varepsilon_3$	$+\frac{5F_T}{3\sqrt{2}}\right)aarepsilon_3$	$+ \frac{F_T}{3\sqrt{2}} \bigg) a\varepsilon_3$
$\varepsilon_4$	$O(\varepsilon^2)$	$O(\varepsilon^2)$	$\left(\frac{F_E}{8\sqrt{3}}\right. +$	$\left(\frac{F_E}{8\sqrt{3}}\right$	$\left(-\frac{F_E}{8\sqrt{3}}\right$	$\left(-\frac{F_E}{8\sqrt{3}}\right. +$
	0 (04)	0 (04)	$+\frac{F_T}{2\sqrt{3}}\right)a\varepsilon_4$	$-rac{F_T}{2\sqrt{3}} ight)aarepsilon_4$	$-rac{F_T}{2\sqrt{3}} ight)aarepsilon_4$	$+ \frac{F_T}{2\sqrt{3}} \bigg) a\varepsilon_4$
	$\left(\frac{F_E}{12} + \right)$	$\left(\frac{F_E}{12}-\right.$	$\left(-\frac{F_E}{24}-\right.$	$\left(-\frac{F_E}{24}+\right.$	$\left(-\frac{F_E}{24}-\right.$	$\left(-\frac{F_E}{24}+\right.$
$\varepsilon_5$	$+\frac{F_T}{3}\right)a\varepsilon_5$	$-\frac{F_T}{3}\right)a\varepsilon_5$	$-\frac{F_T}{6}\right)a\varepsilon_5$	$+\frac{F_T}{6}\right)a\varepsilon_5$	$-\frac{F_T}{6}\right)a\varepsilon_5$	$+\frac{F_T}{6}\right)a\varepsilon_5$
$\varepsilon_6$	$O(\varepsilon^2)$	$O(\varepsilon^2)$	$\left(\frac{F_E}{8\sqrt{6}}\right)$ –	$\left(\frac{F_E}{8\sqrt{6}}\right. +$	$\left(-\frac{F_E}{8\sqrt{6}}\right. +$	$\left(-\frac{F_E}{8\sqrt{6}}\right)$
	0(06)	0(06)	$-\frac{F_T}{\sqrt{6}}\right)a\varepsilon_6$	$+ \frac{F_T}{\sqrt{6}} \bigg) a \varepsilon_6$	$+ \frac{F_T}{\sqrt{6}} \bigg) a \varepsilon_6$	$-rac{F_T}{\sqrt{6}} ight)aarepsilon_6$

Таблица 7. Изменения энергий в орторомбических минимумах, обусловленные деформациями  $arepsilon_i$ 

Из табл. 8 следует, что модуль  $(c_{JT}^T)_{33}$  равен нулю только в случае задачи  $T \otimes e$  ЭЯТ. В соответствии с уравнениями (1) и (2) это означает, что обнаруженное отсутствие аномалий в температурных зависимостях действительной и мнимой составляющих компоненты  $c_{33}$  тензора динамических модулей упругости возможно только при ЭЯТ типа  $T \otimes e$ . Следовательно, можно утверждать, что в кристалле CdSe: Cr<sup>2+</sup> глобальные минимумы адиабатического потенциала имеют тетрагональную симметрию.

### 4. АДИАБАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КОМПЛЕКСА CrSe<sub>4</sub>

Уравнения, описывающие адиабатический потенциал тетраэдрического комплекса  $CrSe_4$  в рамках задачи  $T \otimes e$  ЭЯТ, имеют вид

$$E_n^E = K_E (Q_0^E)^2 + E_n^{\nu}, \qquad (14)$$

где величины  $E_n^{\nu}$  определены в уравнениях (4), n = 1, 2, 3. Таким образом, для построения поверхности адиабатического потенциала необходимо определить два параметра: линейную константу вибронной связи  $F_E$  и силовую константу  $K_E$ . Константа  $F_E$  может быть вычислена с помощью выражений (1)–(3), табл. 8 и экспериментальных данных для температурной зависимости релаксационного вклада  $(c_{ii})_{rel}$  ЯТ-подсистемы в динамические упругие модули  $c_{ii}$  (или в скорость и поглощение соответствующей нормальной моды):

$$(c_{ii})_{rel} = c_{ii}(T) - c_{ii}^b(T),$$
(15)

где  $c_{ii}^b(T)$  — температурная зависимость суммы всех остальных вкладов в динамический модуль  $c_{ii}(T)$ . Процедура выделения релаксационного вклада описана в работах [17, 20]. Уравнение (3) может быть записано для  $T = T_1$ , где  $T_1$  — температура, соответствующая условию  $\omega \tau = 1$ :

$$\frac{(c_{ii}(T_1))_{rel}}{c_{ii}(T_0)} = \frac{(c_{JT}^T(T))_{ii}}{c_{ii}(T_0)} \frac{1-i}{2}.$$
 (16)

	$(c_{JT}^T)_{11}$	$(c_{JT}^T)_{33}$	$(c_{JT}^T)_{44}$	$(c_{JT}^T)_{55}$	$(c_{JT}^T)_{66}$
$T\otimes e$	$-\frac{1}{36} \frac{n_{\rm Cr} a^2 F_E^2}{k_B T}$	0	$-\frac{1}{18}  \frac{n_{\rm Cr} a^2 F_E^2}{k_B T}$	$-\frac{1}{18} \frac{n_{\rm Cr} a^2 F_E^2}{k_B T}$	$-\frac{1}{36}\frac{n_{\rm Cr}a^2F_E^2}{k_BT}$
$T\otimes t_2$	$-\frac{2}{9}\frac{n_{\rm Cr}a^2F_T^2}{k_BT}$	$-\frac{8}{27} \frac{n_{\rm Cr} a^2 F_T^2}{k_B T}$	$-\frac{2}{27} \frac{n_{\rm Cr} a^2 F_T^2}{k_B T}$	$-\frac{2}{27}\frac{n_{\rm Cr}a^2F_T^2}{k_BT}$	$-\frac{4}{27} \frac{n_{\rm Cr} a^2 F_T^2}{k_B T}$
$T\otimes (e+t_2)$	$-\frac{n_{\rm Cr}a^2}{k_BT}\left[\frac{F_E^2}{576}+\right.\\\left.+\frac{F_T^2}{6}\right]$	$-\frac{2}{9}\frac{n_{\rm Cr}a^2F_T^2}{k_BT}$	$-\frac{n_{\rm Cr}a^2}{k_BT}\left(\frac{F_E^2}{288} + \frac{F_T^2}{18}\right)$	$-\frac{n_{\rm Cr}a^2}{k_BT} \left(\frac{F_E^2}{288} + \frac{F_T^2}{24}\right)$	$ -\frac{n_{\rm Cr}a^2}{k_BT} \left(\frac{F_E^2}{576} + \frac{F_T^2}{9}\right) $

Таблица 8. Изотермические вклады ЯТ-подсистемы в упругие модули

Величина  $T_1$  приблизительно определяется положением максимума  $\text{Im}(c_{ii}(T))_{rel}$  (или  $(\alpha_{ii}(T))_{rel})$ , а более точно — положением максимума  $[\text{Im}(c_{ii}(T))_{rel}]T$  (или  $[(\alpha_{ii}(T))_{rel}]T)$  [18].

Из уравнения (16) с учетом изотермического модуля  $(c_{JT}^T)_{44}$ , определенного для задачи  $T \otimes e$ , можно получить выражение для линейной константы вибронной связи:

$$F_E^2 = 72 \frac{k_B T_1 c_{44}(T_0)}{n_{\rm Cr} a^2 k_{44}(T_0)} \, (\alpha_4(T_1))_{rel}.$$
 (17)

Аналогичные выражения можно записать для коэффициентов поглощений всех мод, в которых наблюдается пик релаксационного поглощения (т. е. для  $\alpha_1$ ,  $\alpha_5$  и  $\alpha_6$ ). Определенная таким образом и усредненная по значениям, полученным для различных нормальных мод, константа  $|F_E| = = 1.9 \cdot 10^{-4}$  дин.

На основе данных о поглощении нормальных мод (i = 1, 4, 5, 6) можно построить температурную зависимость времени релаксации [18]:

$$\tau(T) = \frac{1}{\omega} \times \left[ \frac{(\alpha_i(T_1))_{rel}T_1}{(\alpha_i(T))_{rel}T} \pm \sqrt{\left[\frac{(\alpha_i(T_1))_{rel}T_1}{(\alpha_i(T))_{rel}T}\right]^2 - 1} \right].$$
 (18)

На рис. 6 показан результат подбора выражения для  $\alpha_4^b(T)$ , а на рис. 7 — построенная с использованием данных для  $(\alpha_4(T))_{rel}$  температурная зависимость времени релаксации. Видно, что время релаксации определяется двумя активационными процессами: высокотемпературным, характеризующимся временем  $\tau_1$ , и низкотемпературным с характерным временем  $\tau_2$ .

Поскольку в рамках задачи  $T\otimes e$  адиабатический потенциал основного состояния представляет



Рис. 6. Температурные зависимости коэффициентов поглощения (сплошная кривая) и суммы остальных вкладов в поглощение без релаксационного вклада ЯТ-подсистемы (штриховая) для нормальной моды, связанной с модулем  $c_{44}$ ;  $\Delta \alpha_4 = \alpha_4(T) - \alpha_4(T_0)$ ,  $T_0 = 3.7$  K, частота  $\omega/2\pi = 55$  МГц,  $\Delta \alpha_4^b(T) = \alpha_4^b(T) - \alpha_4^b(T_0) =$  $= (-0.01 + 0.00005T + 0.000007T^3)/0.711$ 

собой три независимых параболоида и туннелирование между листами запрещено, релаксация может происходить путем термической активации через возбужденные состояния. Исходя из энергий активации, определенных с помощью рис. 7, можно заключить, что низкотемпературная активация связана со спин-орбитальным расщеплением вибронных уровней, а высокотемпературная — с ближайшим возбужденным вибронным состоянием [21]. Энергии активации этих процессов соответственно равны  $V_2 = 10.5$  K = 7.3 см<sup>-1</sup> =  $14.5 \cdot 10^{-16}$  эрг и  $V_1 = 162$  K = 112 см<sup>-1</sup> =  $224 \cdot 10^{-16}$  эрг.



Рис. 7. Температурная зависимость времени релаксации (кривая 1), полученная на основе данных о поглощении нормальной моды, связанной с модулем  $c_{44}$ , измеренным на частоте  $\omega/2\pi = 55$  МГц. Линия 2 соответствует зависимости  $\tau_1(T) = 10^{-12} \exp(162/T)$ , линия  $3 - \tau_2(T) = 6 \cdot 10^{-7} \exp(10.5/T)$ , а квадрат соответствует значению  $\tau(T_1)$ 

Силовая константа может быть рассчитана с помощью соотношения  $\omega_R^2 = K_E/M$ , где  $\omega_R =$  $= V_1/\hbar$  — радиальная вибронная частота, M = $=4m_{\rm Se}m_{\rm Cr}/(4m_{\rm Se}+m_{\rm Cr})=7.45\cdot10^{-23}$ г — приведенная масса комплекса CrSe<sub>4</sub>. В результате получаем  $K_E = 3.36 \cdot 10^4$  дин/см, энергия ЯТ-стабилизации  $E_{JT} = F_E^2/2K_E = 0.54 \cdot 10^{-12} \text{ spr} = 0.335 \text{ sB} =$ = 2704 см<sup>-1</sup>,  $|Q_0| = 0.57$  Å — смещение минимумов адиабатического потенциала относительно точки  $Q_{\vartheta} = Q_{\varepsilon} = 0$ . При определении силовой константы приведенная масса рассчитывалась с учетом только первой координационной сферы. Такое приближение показалось приемлемым в применении к кубическим кристаллам, в которых локальные оси ЯТ-комплексов совпадают с кристаллографическими осями. В случае вюрцита плотность упаковки больше, что приводит к увеличению эффективной массы за счет более сильной связи комплекса со следующими координационными сферами. Поэтому полученные нами результаты для  $E_{JT}$  и  $|Q_0|$  следует считать оценкой сверху.

#### 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для кристаллов с примесными ионами в трехкратно вырожденном электронном *T*-состоянии разработан метод определения симметрийных свойств деформаций и типа ЭЯТ. Метод основан на расчетах изотермического вклада примесной подсистемы в упругие модули кристалла, поглощение и скорость нормальных мод для всех трех возможных задач,  $T \otimes e$ ,  $T \otimes t_2$  и  $T \otimes (e + t_2)$ , и на сравнении результатов расчета с экспериментальными данными. Эффективность метода была продемонстрирована на примере кристалла CdSe:Cr<sup>2+</sup>, имеющего структуру вюрцита. Были измерены температурные зависимости поглощения и скорости нормальных мод, связанных с упругими модулями  $c_{11}$ ,  $c_{33}$ ,  $c_{44}$ ,  $c_{55}$  и  $c_{66} = (c_{11} - c_{12})/2$ . Проявление ЭЯТ было обнаружено для всех мод за исключением моды, связанной с модулем сзз. Анализ локальных искажений ЯТ-центров CrSe<sub>4</sub>, создаваемых объемными нормальными модами, показал, что аномалии, связанные с ЭЯТ, возможны только в случае задачи  $T \otimes e$ . На основе данных, полученных в ходе ультразвуковых исследований, в рамках задачи  $T\otimes e$  определены такие параметры адиабатического потенциала основного состояния, как энергия ЯТ-стабилизации, линейная константа вибронной связи, силовая константа, положения минимумов адиабатического потенциала и радиальная вибронная частота.

Финансирование. Работа выполнена при поддержке Лаборатории сильных магнитных полей, Дрезден, ФРГ (Hochfeld-Magnetlabor Dresden (HLD-EMFL), Dresden-Rossendorf, Germany), Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-02-00332а), Центра превосходства «Радиационные и ядерные технологии» Уральского федерального университета и в рамках государственного задания Министерства образования и науки России (тема «Электрон», № АААА-А18-118020190098-5).

Работа подготовлена по итогам XXXVIII Совещания по физике низких температур (HT-38).

## ЛИТЕРАТУРА

- V. I. Kozlovsky, V. A. Akimov, M. P. Frolov, Yu. V. Korostelin, A. I. Landman, V. P. Martovitsky, V. V. Mislavskii, Y. P. Podmar'kov, Y. K. Skasyrsky, and A. A. Voronov, Phys. Stat. Sol. (b) 247, 1553 (2010).
- E. Malguth, A. Malguth, and M. R. Phillips, Phys. Stat. Sol. (b) 245, 455 (2008).

- P. Rabl, S. J. Kolkowitz, F. H. L. Koppens, J. G. E. Harris, P. Zoller, and M. D. Lukin, Nature Phys. 6, 602 (2010).
- I. B. Bersuker, *The Jahn-Teller Effect*, Cambridge Univ. Press, Cambridge (2006).
- I. B. Bersuker and V. Z. Polinger, Vibronic Interactions in Molecules and Crystals, Springer, Heidelberg (1989).
- G. Bevilacqua, L. Martinelli, E. E. Vogel, and O. Mualin, Phys. Rev. B 70, 075206 (2004).
- 7. М. М. Зарипов, В. Ф. Тарасов, В. Ф. Уланов, Г. С. Шакуров, ФТТ 44, 1958 (2002).
- M. D. Sturge, in Solid State Physics: Advances in Research and Applications, Vol. 20, ed. by F. Seitz, D. Tumbull, and H. Ehrenreich, Acad. Press, New York (1967), p. 92.
- V. V. Gudkov, I. B. Bersuker, I. V. Zhevstovskikh, Yu. V. Korostelin, and A. I. Landmann, J. Phys.: Condens. Matter 23, 115402 (2011).
- I. V. Zhevstovskikh, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov, N. S. Averkiev, M. N. Sarychev, S. Zherlitsyn, Sh. Yasin, G. S. Shakurov, V. A. Ulanov, and V. T. Surikov, J. Appl. Phys. **119**, 225108 (2016).
- N. S. Averkiev, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov, K. A. Baryshnikov, I. V. Zhevstovskikh, V. Yu. Mayakin, A. M. Monakhov, M. N. Sarychev, V. E. Sedov, and V. T. Surikov, J. Appl. Phys. **116**, 103708 (2014).
- N. S. Averkiev, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov, K. A. Baryshnikov, G. V. Colibaba, I. V. Zhevstovskikh, V. Yu. Mayakin, A. M. Monakhov, D. D. Nedeoglo, M. N. Sarychev, and V. T. Surikov, Phys. Stat. Sol. (b) 251, 1590 (2014).

- 13. V. A. Akimov, M. P. Frolov, Y. V. Korostelin, V. I. Kozlovsky, A. I. Landman, Y. P. Podmar'kov, and Y. K. Skasyrsky, Opt. Mater. 31, 1888 (2009).
- 14. *Акустические кристаллы*, под ред. М. П. Шаскольского, Наука, Москва (1982), с. 205.
- V. V. Gudkov and J. D. Gavenda, in *Magnetoacoustic Polarization Phenomena in Solids*, Springer-Verlag, New York (2000), p. 25.
- S. Zherlitsyn, S. Yasin, J. Wosnitza, A. A. Svyagin, A. V. Andreev, and V. Tsurkan, Low Temp. Phys. 40, 123 (2014).
- V. V. Gudkov, in *The Jahn-Teller Effect. Fundamen*tals and Implications for Physics and Chemistry, ed. by H. Koppel, D. R. Yarkony, and H. Barentzen, Springer, Heidelberg–Dordrecht–London–New York (2009), p. 743.
- 18. V. V. Gudkov and I. B. Bersuker, in Vibronic Interaction and the Jahn-Teller Effect. Theory and Applications, ed. by M. Atanasov, C. Daul, and Ph. L. W. Tregenna-Piggot, Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York (2012), p. 149.
- 19. Y. P. Varshni, Phys. Rev. B 2, 3952 (1970).
- 20. N. S. Averkiev, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov, I. V. Zhevstovskikh, M. N. Sarychev, S. Zherlitsyn, S. Yasin, G. S. Shakurov, V. A. Ulanov, and V. T. Surikov, J. Phys. Soc. Jpn. 86, 114604 (2017).
- 21. N. S. Averkiev, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov, I. V. Zhevstovskikh, K. A. Baryshnikov, M. N. Sarychev, S. Zherlitsyn, S. Yasin, and Yu. V. Korostelin, Phys. Rev. B 96, 094431 (2017).